

B81C    マイクロ構造装置またはシステムの製造または処理に、特に適合した方法または装置(マイクロカプセルまたはマイクロバルーンの製造 B 0 1 J 1 3 / 0 2 ; 圧電素子, 電歪素子, または磁歪素子自体の製造や処理に特に適した方法または装置 H 1 0 N 3 0 / 0 1 ) [ 7 ]

注

注 [ 7 ]

このサブクラスは、以下のものを包含しない：

・純粋に電氣的または電子的装置の製造または処理のための方法または装置，これらは H セクション，例えば，サブクラス H 1 0 P に分類する；

・単一の原子または分子の操作を行う方法または装置，これらはグループ B 8 2 B 3 / 0 0 に分類する。

1/00      基層中または基層上での装置またはシステムの製造または処理 ( B 8 1 C 3 / 0 0 が優先 ) [ 7 ]

3/00      個別に処理された構成部品からの，装置またはシステムの組立 [ 7 ]

99/00     このサブクラスの他のグループに分類されない主題事項 [ 2 0 1 0 . 0 1 ]